

# 2SA807, 2SA808, 2SA808A

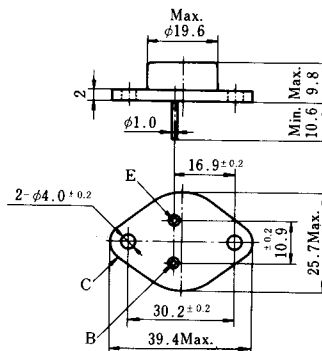
■シリコンPNPエビタキシャルメサ形トランジスタ

○一般用

■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SA807	2SA808	2SA808A
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CB0</sub>	-60V	-80V	-100V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	-60V	-80V	-100V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EB0</sub>	-6V		
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	-6A		
ベース電流	I <sub>B</sub>	-3A		
許容コレクタ損失	P <sub>C</sub>	50W (フランジ温度25°C)		
接合部温度	T <sub>J</sub>	150°C		
保存温度	T <sub>stg</sub>	-65 ~ +150°C		

外形寸法 (単位: mm)  
JEDEC (TO-3), EIAJ (TC-3, TB-3)



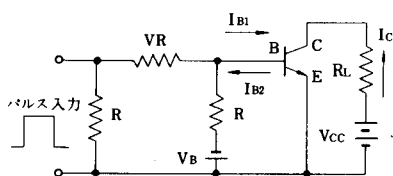
■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SA807	2SA808	2SA808A
最大コレクタしゃ断電流	I <sub>CB0</sub>		-1.0mA	-1.0mA	-1.0mA
		V <sub>CB</sub> =	-60V	-80V	-100V
最大エミッタしゃ断電流	I <sub>EB0</sub>	V <sub>EB</sub> = -6V	-1.0mA		
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> = -50mA	-60V	-80V	-100V
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = -4V I <sub>C</sub> = -3A	20 Min.		
コレクタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -3A I <sub>B</sub> = -0.3A	-1.5V Max.		
しゃ断周波数	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = -12V I <sub>E</sub> = 0.5A	10MHz Typ.		

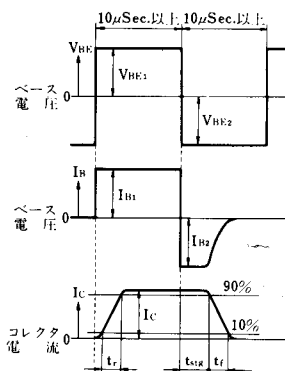
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V <sub>CC</sub> (V)	R <sub>L</sub> (Ω)	I <sub>C</sub> (A)	I <sub>B1</sub> (mA)	I <sub>B2</sub> (mA)	t <sub>r</sub> (μSec.)	t <sub>stg</sub> (μSec.)	t <sub>f</sub> (μSec.)
-10	3	-3	-300	50	1.2	1.8	0.3

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

